



三菱ケミカル株式会社
東京都千代田区丸の内 1-1-1 パレスビル
〒100-8251

2021年11月19日付 株式会社日本製鋼所・三菱ケミカル株式会社プレスリリース「世界最大級の GaN 基板製造実証設備で 4 インチ GaN 結晶の成長を確認— 超高効率デバイス実現への貢献を目指し、さらなる高品質化を継続 —」の訂正について

国立大学法人東北大学と株式会社日本製鋼所及び三菱ケミカル株式会社は、2013 年度から「酸性アモノサーマル法による高品質大口径 GaN パルク GaN 単結晶の作製技術実用化開発」等のテーマで、共同研究を実施してきました。

しかしながら、2021 年 11 月 19 日付、株式会社日本製鋼所・三菱ケミカル株式会社によるプレスリリース「世界最大級の GaN 基板製造実証設備で 4 インチ GaN 結晶の成長を確認— 超高効率デバイスの実現に貢献、2022 年度から市場供給開始予定—」において、「酸性アモノサーマル技術 (SCAAT™)」が三菱ケミカル株式会社独自の液相成長技術との記載したことに対し東北大学から、東北大学および株式会社日本製鋼所の協力のもとに確立した技術であることを明示するよう、記事訂正の申し入れがございました。

当社は東北大学の指摘を真摯に受け止め、下記のとおり当該プレスリリースから“三菱ケミカル独自の液相成長技術 (Super Critical Acidic Ammonia Technology, 以下「SCAAT™)」” という文言を削除するとともに、GaN に関わるニュースアーカイブについても訂正いたしました。

・2021 年 11 月 19 日付、株式会社日本製鋼所・三菱ケミカル株式会社によるプレスリリース「世界最大級の GaN 基板製造実証設備で 4 インチ GaN 結晶の成長を確認— 超高効率デバイスの実現に貢献、2022 年度から市場供給開始予定—」

(https://www.m-chemical.co.jp/news/2021/_icsFiles/afieldfile/2022/06/05/20211119_GaN.pdf)

・2021 年 5 月 18 日付ニュースリリース “世界最大級の窒化ガリウム (GaN) 基板製造設備の竣工について”

(https://www.m-chemical.co.jp/news/2021/_icsFiles/afieldfile/2022/06/05/20210518_GaN.pdf)

以上